Chinese Rare Earths

镧离子掺杂 M 型钡铁氧体的结构及磁性研究

古映莹,冯慧芬,胡肖华,漆坤熠

(中南大学 化学化工学院 有色金属资源化学教育部重点实验室 湖南 长沙 410083)

摘 要:采用化学共沉淀法制备了镧掺杂的 M 型钡铁氧体粉体 $BaLa_xFe_{12-x}O_{19}$ ($x=0\sim0.5$)。运用 X 射线衍射仪(XRD)以及振动样品磁强计(VSM)等仪器对产物进行了结构和磁性等的表征。结果表明 在研究范围内 La^{3+} 掺杂量对产物物相没有影响 但随着离子掺杂量的增多 "产品的平均粒径略有增大; La^{3+} 掺杂进入钡铁氧体后会产生一定的晶格畸变 造成晶面间距的增大; 随着 La^{3+} 掺杂量的增加 "产品的密度和电阻率逐渐减小 ,饱和磁化强度和剩余磁化强度均有所下降 ,矫顽力也有一定程度的降低。

关键词:镧离子掺杂; M 型钡铁氧体; 磁性能

中图分类号:TQ174.1 文献标识码:A 文章编号:1004-0277(2012)06-0070-05

M 型钡铁氧体由于成本低、磁饱和强度大、具 有较高的磁矫顽力和电阻率以及化学性质稳定等特 点 被广泛应用于永磁材料、高密度磁性毫米波器件 等。钡铁氧体的开发利用是磁性材料工业中的一个 重要发展方向[1]。M 型钡铁氧体的制备方法主要 有低温化学法、喷雾热解法、化学共沉淀法、水热法、 玻璃晶化法、微乳液法、金属有机物水解法、有机树 脂法、自蔓延高温合成法、溶胶 - 凝胶法等等。 传统 的固相法如热分解法、球磨法等用于制备钡铁氧体 具有不可避免的缺陷 如易引入杂质、原料很难均匀 混合、反应量不受控制、很难进行准确的离子掺杂 等。相对于固相法 湿化学法比较简单 易于规模化 生产 特别适合干制备纳米粉体。湿化学法包括化 学共沉淀法[23]、水热法[4]、溶胶 - 凝胶法[56]等。 本文采用的共沉淀法工艺流程简单,可制备出粒径 分布窄、颗粒均匀的钡铁氧体。 另外 ,通过共沉淀法 进行离子掺杂能够让掺杂离子与主体在原子、分子 级别上进行充分混匀,可以精准地控制离子掺杂量, 达到制备高性能钡铁氧体的目的。一般作为高密度 磁性记录材料 必须降低材料的内禀矫顽力[78] ,通 常采用二价和四价离子(如 Co - Ti 等)联合取代钡 铁氧体中的 Fe3+ 来达到这一目的[9,10]。通过掺杂

或组合掺杂实现各种离子代换 ,是研究磁性材料的 交换作用、磁晶各向异性等本征特性及改善材料性 能和物理性能的重要方法之一[11]。目前,多数研究 者仍然采用此类方法来提高 M 型钡铁氧体的各种 性能 且大多集中在二元联合替代的研究上 仅有少 量一元和三元替代的报道。一元替代关注的多为离 子替代后其晶体结构发生的变化,为二元替代提供 可参考的资料。早在20世纪七、八十年代就发现, 添加 La³⁺可以提高永磁铁氧体的性能^[12]。稀土元 素原子或离子具有许多特殊的电磁性质 如顺磁磁 化率、磁晶各向异性、磁致收缩等[13] 是纳米复合铁 氧体的重要添加剂之一。这是由于稀土元素具有丰 富的 4f 层电子(4f 层电子对离子磁矩有贡献) .且外 面还有6s²等电子,这些外围电子层起到了屏蔽的作 用 避免了每个稀土离子内部的 4f 电子受到邻近离 子的影响。稀土离子与铁氧体中过渡金属离子的4f -3d 轨道间的偶合作用对铁氧体的粒径、晶胞参 数、形貌和磁性能会产生较大的影响[14,15]。为了制 备出性能卓越的钡铁氧体材料,并且能够精准地控 制离子掺杂量 本实验采用共沉淀法对钡铁氢体进 行 La³⁺掺杂 ,分别考察了不同掺杂量对产品物相及 电磁性能的影响。

基金项目: 中南大学贵重仪器设备开放共享基金(CSUZC2012040)

作者简介: 古映莹(1962-) ,女 ,湖南长沙人 ,硕士 教授 ,研究方向: 无机功能材料的合成。

^{*} 收稿日期: 2012-04-09

1 实验部分

1.1 镧离子掺杂 M 型钡铁氧体的制备 本实验所用试剂均为分析纯。

采用硝酸铁(Fe(NO₃) $_3$ • 9H₂O)、硝酸钡(Ba (NO₃) $_2$) 及硝酸镧(La(NO₃) $_3$) 为原料,按一定掺杂比例称取适量的原料,溶解于事先加入一定量硝酸的去离子水中。另外参照 Fe 与 Ba 的量称量稍过量的 Na₂CO₃ 与 NaOH 将其溶解于一定量水中,加入适量的分散剂,搅拌摇匀。在加热和搅拌的条件下,将金属离子混合溶液缓慢匀速地滴加到沉淀剂溶液中,同时用 pH 计监测溶液 pH 值,通过滴加3 mol • L $^{-1}$ NaOH 溶液保持混合液的 pH 值稳定。反应完全后继续搅拌 1 h,陈化 1 h,然后过滤,用去离子水和无水乙醇反复洗涤沉淀 8 ~ 9 次,直至滤液为中性。然后将沉淀于 80 $^{\circ}$ C 烘箱中烘干,研磨过筛 在一定温度下煅烧一定时间,即得到掺杂的 M型钡铁氧体粉体。

1.2 表征与性能测试

用 Buker 全自动 X 衍射仪 , $CuK_{\alpha l}$ 辐射($\lambda = 0.154056$ nm) ,扫描范围为 $10^{\circ} \sim 80^{\circ}$,扫描速度为 0.02° /s 分析产品的物相结构; 用比重瓶法(GB - 5161 - 85) 测定产品的密度; 用 HZZ810 型 LCR 数字电桥测定粉体的电阻率; 用 JDM - 13 型振动样品磁强计测定产品的磁性能。

2 结果与讨论

2.1 XRD 结果分析

图 1 是不同 La^{3+} 掺杂量所得的 $BaLa_xFe_{12-x}O_{19}$ 样品的 XRD 图谱。

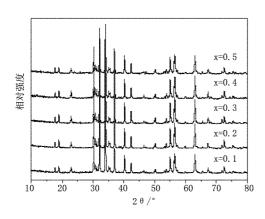


图 1 不同 La³⁺掺杂量样品的 XRD 图谱

Fig. 1 XRD pattern of different doping amount of La³⁺

由图 1 可见 ,5 个样品在 $2\theta = 18.9^{\circ} \times 30.3^{\circ} \times 32.2^{\circ} \times 34.1^{\circ} \times 37.1^{\circ} \times 40.3^{\circ} \times 56.6^{\circ} \times 63.1^{\circ}$ 等处均出现了六角型 $BaFe_{12}O_{19}$ 的特征峰(PDF43 -0002) ,因此 ,可以认为掺杂 La^{3+} 制备出的产品均是纯相物质 ,没有出现 $Fe_{\circ}Ba$ 或者 La 的化合物的衍射峰。这说明了 La^{3+} 进入了 M 型钡铁氧体的晶格里面 ,且没有改变其晶体结构。

采用 MDI Jade 5.0 软件计算产品的晶面间距与晶粒的平均粒径 研究它们和 La³⁺掺杂量之间的关系。利用下面的公式来计算样品的晶面间距^[16]。

$$a = d \cdot (h^2 + k^2 + l^2)^{\frac{1}{2}}$$
 $d = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$

同时根据 Scherrer 公式可以计算出晶粒的平均粒径。

$$D_{\rm hkl} = \frac{0.89\lambda}{\beta_{\rm i} cos \theta}$$

式中: a 是晶格常数(nm); h λ λ 表示晶面指数; d 为晶面间距 μ , nm; λ 为入射 λ 射线波长 μ 为布拉格衍射角 μ μ 为 λ 射线衍射峰的半高宽(弧度) 。

计算结果列于表 1 中。通过计算可知,随着 La^{3+} 掺杂量的增加,产品的 XRD 衍射峰晶面间距略 有增加,其平均粒径随之增大。这是由于 La^{3+} 的半径($106\,$ pm) 大于 Fe^{3+} 的半径($67\,$ pm), La^{3+} 取代部分 Fe^{3+} 进入了 $BaFe_{12}O_{19}$ 晶格中,导致晶格畸变,晶格常数增加。

表 1 不同 La³⁺ 掺杂量对产物晶面间距和晶粒 平均粒径的影响

Table 1 The impact of different doping amount of La³⁺ ion on the interplanar spacing and the average grain size

h	k	l	2θ /°			x = 0.3		x = 0.5	
					D/nm	d/pm	D/nm	d/pm	D/nm
1	1	0	30.254	295.01	44.4	295.08	44.5	295.12	46.0
1	1	4	34.052	263.02	44.6	263.02	45.1	263.15	46.8
2	0	3	37.107	242.58	45.7	242.60	48.1	242.63	48.9
2	0	5	40.255	223.75	40.0	223.78	47.1	223.82	48.5
2	1	7	54.996	166.63	35.4	166.65	43.5	166.76	44.1

2.2 密度结果分析

实验考察了产品密度与 La³⁺掺杂量之间的关系 结果见图 2。从图 2 可以看出 随着 La³⁺掺杂量的增加 产品的密度下降。这是因为掺杂的 La³⁺半径比 Fe³⁺大 ,掺杂后形成固溶体造成产物晶格畸变 粒径变大 同时孔隙率也相应的增大。

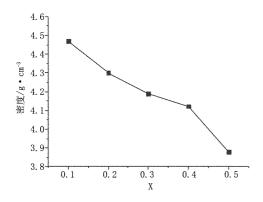


图 2 不同 La³⁺掺杂量对产品密度的影响 Fig. 2 The impact of different doping amount of La³⁺ ion on the density of the samples

2.3 产品室温电阻率

电阻率是微波吸收材料的一个重要的物理参数 ,当材料电阻率处于半导体范围($10^{-5} \Omega \cdot m \sim 10^7 \Omega \cdot m$) 时 ,很有利于吸波材料的吸波性能。图 3 是产品电阻率与离子掺杂量之间的关系图。

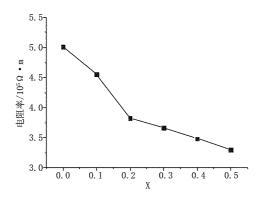


图 3 产品电阻率与 La³⁺ 掺杂量的关系 Fig. 3 The relationship between different doping amount of La³⁺ ion and electrical resistivity

从图 3 可以看出,室温下未掺杂的 $BaFe_{12}O_{19}$ 粉体电阻率值较高,处于半导体范围,随着离子掺杂量的增多, $BaLa_xFe_{12-x}O_{19}$ 的电阻率呈下降趋势。 这是因为离子进入晶格之后取代部分 Fe^{3+} ,晶格常数变大而造成晶格畸变,提高了粉体的物理活性,使得电阻率降低。

2.4 产品磁性能分析

对所得到的 La^{3+} 掺杂的 M 型钡铁氧体粉末用振动样品磁强计(VSM) 进行磁性能测量。图 4 是产品在外加磁场中的磁滞回线。

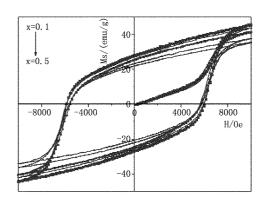


图 4 产品在外加磁场中的磁滞回线图 Fig. 4 The hysteresis loop of sample in an external magnetic field

表 2 不同 La³⁺ 掺杂量粉体的磁性能参数

Table 2 The magnetic parameters of the power with different doping amount of La³⁺ ion

La ³⁺ 掺杂量	Ms/(emu • g ⁻¹)	Нс/Ое	Mr/(emu \cdot g ⁻¹)
x = 0	52.47	5961.36	31.70
x = 0.1	45. 64	5952. 14	28. 36
x = 0.2	43. 88	5880. 08	27. 30
x = 0.3	41.73	5636. 32	25. 72
x = 0.4	37. 56	5774.72	23. 20
x = 0.5	35. 42	5689. 70	21. 94

从上面的图表可以知道 ,制备出的产品属于硬磁材料 ,因为它们的矫顽力在 2kOe ~ 5kOe 之间 ,属于硬磁材料的范畴。

根据表 2 数据可以得到下面的曲线关系图: La^{3+} 掺杂量与产品的饱和磁化强度及矫顽力之间的关系如图 5 及图 6 所示。

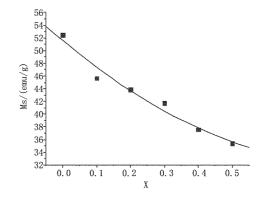


图 5 La³⁺ 掺杂量与产品的饱和磁化强度的关系图 Fig. 5 The relationship between different doping amount of La³⁺ ion and saturation magnetization

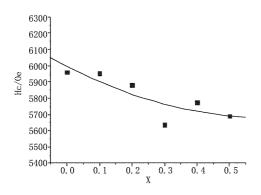


图 6 La³⁺掺杂量与产品矫顽力的关系图 Fig. 6 The relationship between different doping amount of La³⁺ ion and coercivity of samples

从图 4 和图 5 可知 随着镧离子掺杂量的增加,产品的饱和磁化强度缓慢下降。这是因为产品的磁性与掺杂离子在 $BaFe_{12}O_{19}$ 晶格位点分布以及磁稀释作用(即由于掺杂了磁矩较低的离子导致的非共线结构(自旋倾斜))相关^[17]。掺杂离子倾向于占领 $BaFe_{12}O_{19}$ 晶格中自旋方向向上的位点(如 $12k \cdot 2a$ 和 $4f_1$ 位点)的 Fe^{3+} ,严重破坏了晶体中的 $Fe^{3+} - O - Fe^{3+}$ 超交换作用。另外,每个 $4f_1$ 位点均和 3 个 12k 位点相邻,离子取代 12k 位点上的 Fe^{3+} 后 $Af_1 - 12k$ 之间的磁超交换作用受到干扰,这些原因导致粉体的饱和磁化强度随着掺杂量的增大而降低。。

图 6 显示了不同的离子掺杂量对产品矫顽力的影响。从图 6 可以看出,掺杂镧的样品矫顽力受离子掺杂量的影响较小,下降不明显。矫顽力与晶粒的大小有较大的关系,粒径小有助于提高晶粒的矫顽力[17]。XRD 分析结果显示,随着离子掺杂量的增加产品的粒径是呈增大的趋势,所以,随着离子掺杂量的增多,在相同的制备条件下,产品的矫顽力会有一定程度的减弱。

3 结论

- 1. XRD 结果表明 不同的 La³⁺掺杂量得到的产品全是纯相的物质; 根据 XRD 的结果计算产品的平均粒径可以发现 随着离子掺杂量的增多 样品晶粒的平均粒径略有增大。
- 2. 随着 La³⁺掺杂量的增多 ,所制备的钡铁氧体 的密度和电阻率均呈下降趋势。
- 3. 不同的 La³⁺ 掺杂量对所制备的钡铁氧体的磁性能有较大的影响。通过相应的表征可知 ,随着 La³⁺ 掺杂量的增加 ,饱和磁化强度和剩余磁化强度均有所下降 ,矫顽力也有一定程度的降低。

参考文献:

- [1] 黄凯 浏先松 ,周圣强 ,等. La、Co 取代对 M 型锶铁氧体结构和磁性能的影响 [J]. 磁性材料及器件 ,2006 ,37(4):17-20.
- [2] Pramanik N C ,Fujii T ,Nakanishi M ,et al. Development of nanograined hexagonal barium ferrite thin films by sol – gel technique [J]. Materials Letters ,2005 ,59 (4): 468– 472.
- [3] Zahi S ,Hashim M ,Daud A R. Synthesis ,magnetic properties and microstructure of Ni Zn ferrite by sol gel technique [J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2007 308: 177-182.
- [4] Miha Drofenik ,Matjam Kristl. Hydrothermal synthesis of Ba – hexaferrite nanoparticles [J]. Journal of the American Ceramic Society. 2007 90: 2057-2061.
- [5] Kishan Reddy N Mulay V N. Magnetic properties of W type ferrites [J]. Mater Chem Phys 2002, 76: 75 –77.
- [6] Sudakar C ,Subbanna G N ,Kutty T R N. Wet chemical synthesis of multicomponent hexaferrite by gel – to – crsy– stalline conversion and their magnetic properties [J]. Magn Magn Mater 2003 263: 253-68.
- [7] De G ,Tapfer L ,Catalano M ,et al. Formation of copper and silver nanometer dimension clusters in silica by the sol – gel process [J]. Applied Physics Letters ,1996 ,68: 3820-3822.
- [8] Mallick K K Shepherd P Green R J. Dielectric properties of M – type barium hexaferrite prepared by co – precipita– tion [J]. Journal of the European Ceramic Society 2007, 27: 2045–2048.
- [9] Kubo O ,Ido T ,Yokoyama H. Properties of Ba ferrite particles for perpendicular magnetic recording media [J].
 IEEE Transactions on Magnetics ,1982 ,18:1122-1124.
- [10] Sugimoto S ,Haga ,K Kagotani T ,et al. Microwave absorption roperties of Ba M type ferrite prepared by a modified coprecipitation method [J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 2005 ,290-291 : 1188–1191.
- [11] 乔梁 蔣梅燕 ,郑精武 ,等. 自蔓延高温 La Zn 掺杂 锶铁氧体改性研究 [J]. 材料工程 2007(8): 20-23.
- [12] 段红珍,李凤生,李巧玲.棒状纳米钡铁氧体的制备 及镧掺杂对其性能的影响[J].材料科学与工程学 报 2007 25(2): 179-181.
- [13] 谢炜 程海峰 唐耿平 ,等. 稀土吸波材料的吸波机理与研究现状 [J]. 材料导报 2005 ,19(F05): 291-293.
- [14] 庄稼 胨学平 迟燕华 ,等. 掺杂 Co^{2+} 和 Sm^{3+} 对纳米 $\mathrm{ZnFe_2O_4}$ 铁氧体的电磁损耗性质的影响 [J]. 化学学报 2006 64(2) ,151-157.
- [15] 徐烽 李良超 蔣静 等. $Zn_{0.4}Ni_{0.6}Cr_{0.5}La_xFe_{1.5-x}O_4$ 铁 氧体纳米粉晶的制备及磁性 [J]. 化学学报 2007 65

(9) \$16-820.

[16] 原晓波,刘宜华,黄宝歆,等. Ti 掺杂对 La_{0.67} Ba_{0.33} MnO₃ 磁性和磁电阻影响[J]. 功能材料与器件学报, 2004,10(2):195-199.

[17] Ounnunkad S ,Winotai P. Properties of Cr – substituted M – type barium ferrites prepared by nitrate – citrate gel – autocombustion rocess [J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2006 301(2):292-300.

Study on the Structure and Magnetic Properties of La³⁺ - doped Ba - M - type Hexagonal Ferrites

GU Ying-ying FENG Hui-fen HU Xiao-hua QI Kun-yi

(Key Laboratory of Resources Chemistry of Nonferrous Metals School of Chemistry and Chemical Technology , Central South University ,Changsha 410083 ,China)

Abstract: Ba – M – type hexagonal ferrites ($BaFe_{12}O_{19}$) with different doping amount of La^{3+} ion $BaLa_xFe_{2-x}O_{19}$ (x=0 ~0.5) have been prepared by co – precipitation method. The phase structure and magnetic properties of samples were studied by X – ray diffraction and vibrating sample magnetometer and so on. The results showed that the doping amount of La^{3+} ion in the range of 0 ~0.5 has no influence on purity of product but average crystal size of the samples increased slightly with the increasing of doping amount of La^{3+} ion; La^{3+} ion doped into barium ferrite crystal lattice will have some distortion resulting in the increase of interplanar spacing; meanwhile product density electrical resistivity saturation magnetization remanent magnetization and coercivity decreased respectively with the increasing amount of doping ions.

Key words: La³⁺ doping; Ba – M – type ferrites; magnetic properties

美国能源部开发出 LED 封装制造成本模型 LEDCOM

美国能源部开发了一个 LED 封装制造成本模型 便于企业评估改变 LED 制造流程的不同方面所产生的效果,如使用不同的衬底或引进新的生产设备。

模块化 LED 成本模型(LEDCOM) 集合之前 DOE 研讨会和圆桌会议的讨论提供了一个简化的 LED 封装制造成本分析的方法。LEDCOM 模型专注于 LED 制造成本的主要元素,包括初步的原始数据和基本的制造流程。这些提供了一个起点,可以由用户自定义模型不同的工艺、材料和设备。

该工具适用于参与 LED 封装制造的厂商 "从材料和设备供应商到外延片、晶圆处理器、芯片制造商和封转商。它将评估出在制造过程中不同点上对 LED 封装成本变化的相对影响。

例如,该工具可以评估不同基板尺寸或类型、制作工艺、原材料成本和制造设备变化所造成的价格改变。它也可以被用来帮助完成成本效益分析,以量化 R&D 的价值、分析预期的改善将对最后 LED 封装成本的影响。

[中国稀土网站]